

和 文 索 引

あ

アイコノスコープ	60	アモルファス合金膜	791	イオンビームスパッタ法	843
アインシュタインの関係式	513	アモルファス薄膜	864	イオンプラズマ周波数	732
青写真	31	アモルファス半導体	805	イオンプレーティング法	843
アーク	248	——のバンドモデル	762	イオンマイクロプローブ	235
アクセプタ	497, 510	——ヘテロ多層膜構造	789	異質核形成	404
深い——	497	4 配位系 2 元合金——	791	異常光線屈折率	451
アクティブマトリクス	929	アモルファスワイヤ	835	異常電子配置	784
アクティブマトリックス方式	641	アモントン-クーロンの法則	333	異常透過	470
アーク放電	378	アーリー効果	589	異常分散ガラス	4
アクロマート対物レンズ	18	アルカリハライド基板	901	異常ホール効果	847
アサーマルガラス	5	アルカンチオール	898	イジング-スピン系	287
浅い準位	473	アルニコ磁石	836	位相共役鏡	15
アジド化合物	31	α 線	592	位相共役波	15
アスファルト	31	アルミニウム-キノリノール錯体	927	位相コヒーレンス長	627, 630
圧電基本式	524	Al の流動	692	位相コントラスト	220, 263
圧電効果	524	アレイ導波路格子型	118	位相差顕微鏡	19
圧電性	899	荒れた面	405	位相差コントラスト法	874
圧電テンソル	524	暗視野顕微鏡	936	移相子	8
圧電半導体	525	アンジュレータ	210, 268	位相シフト法	43
アップ数	4	アンジュレータ挿入光源	262	位相整合	123
圧力センサ	644	アンジュレータ放射	210	位相接続	43
アトムプローブ	302	アンダーソン局在	763	位相板	19, 28
アトムプローブ電界イオン顕微鏡	305, 332	Anderson 則	527	位相モード型論理素子	199
アナログ集積回路	623	アンテナ効果	707	1 次イオン	229
アナログフィルタ	960	イオン	726	一次温度計	1011
アニール	738	イオンアシストエッチング	727	一軸 (単軸) 磁気異方性	822
アノード水素遊離モデル	707	イオンアシスト反応	727	一軸性結晶	451
アノードホール注入モデル	707	イオン打込み転送路	867	1 次元の電子系	545
アーバック焦点	767	イオン化エネルギー	564	1 次コイル	1024
アハラノフ-ボーム効果	628, 630	イオン化確率	233	一重項状態	93
アバランシュ増倍	60	イオン化不純物散乱	513	一重項励起子の生成効率	926
アバランシュ増倍係数	515	イオン交換膜	414	一重項励起状態	926
アフィニティ準位	324	イオン散乱分光	308	一方向磁気異方性	822
アマクリン細胞	71	イオンシース	731	一括描画	721
アモルファス	833	イオン衝撃	727	一定光電流法	782
アモルファス合金		イオン性度	501	イットリウム鉄ガーネット	867
Co 基——	833	イオン像	231	移動度	496, 607, 917
Fe 基——	834, 878	イオン窒化	709	移動度ギャップ	764
		イオン注入法	738	移動度端	764
		イオンドーピン法	607	——近傍の電気伝導	764
		イオンナノプローブ	235	移動レンズ	213
				異方性	898

異方性エッチング	727	液滴様合体	368	エンハンスメント型	595
異方性磁界	823	エキストラクタ真空計	1047	治面成長	405
異方性磁気抵抗	847	エサキ・ダイオード	582		
異方性ボンド磁石	841	エシエル格子	24	置換位置	235
イメージオルシコン	60	エシレット格子	23	オキサジアゾール誘導体	927
イメージコンバータカメラ	1028	SN 比	950	オージェ過程	239, 516
イメージング測定	559	エタロン	24	オージェ電子分光	291, 297, 364
色収差	221	X 線干渉計	472	遅い利得飽和作用	130
色の見えモデル	74	X 線 CT	936	オゾン	441
色分散	115	X 線 CTR 散乱	394	オートコリメータ	982
印加電圧	926	X 線回折	795	オートフォーカス法	43
インコヒーレント-コヒーレント変換	12	X 線回折強度測定法	467	オーバライト	35
因子	968	X 線検出深さ	225	オフナー型	21
インスタント写真	31	X 線検出面積	225	オペアンプ	959
インターフェログラム	25	X 線顕微鏡	262	オボニック効果	801
インターミディエイト配線	685	X 線分光系	223	オーミックコンタクト	690
インターライントランスファ型	60	X 線光電子分光法	916	音響光学効果	10, 454
インテリジェントセンサ	647	X 線ディフラクトメータ	255	オンサガー半径	769
インパクトイオン化	708	X 線トポグラフィ	256, 467, 469	音速温度計	987
インパー合金	831	X 線反射率法	394	オンチップマイクロレンズ	60
インパットダイオード	584	X 線レーザ	101	温度降下法	413
インピーダンス計	997	エッチストップ	731, 734	温度上昇	330
in-plane 回折法	257, 391	エッチバック法	694	温度の標準	976
		エッチピット	898	温度変調分光法	790
ウィグナー結晶	538	エッチング	56, 441		
ウィグナー-サイツ・セル	504	ラジカルによる——	727	か	
ウィグラー	209	エッチング形状	727		
Wilhelmy 法	894	エッチング選択性	727, 728	開管法	425
Wind & React 法	177	エッチング速度	727	回帰係数	970
ヴェガード則	103, 256, 509	エドレンの式	980	回帰分析	970
ウェット酸化	708	エネルギーギャップ	155, 496	開口数	113
ヴェルデ定数	455	エネルギー損失	914	χ^2 分布	967
ウォルシュ-アダマール変換	966	エネルギー損失因子	235	回収衛星	1058
動き検出チップ	647	エネルギー帯分散	911	回析限界	6
渦電流損失	828, 875	エネルギー等分配則	288	解析格子	23
Wood の表示法	286	エネルギーバランス	514	回折コントラスト	219
埋込みフォトダイオード	60	エネルギー分解能	235, 236	回折収差	221
埋込み分離	679	エネルギー分散型 X 線分光計	224	階層性	935
埋戻しパルス	473	エネルギー変換効率	637	階段接合	577
ウラン濃縮	135	エネルギーゆらぎ	236	回転検光子法	28
ウルツ鉱型構造	365, 502	エバース-モル・モデル	591	回転振動法	470
		エバネッセント場	54	回転するエピタキシー	287
永久電流	150	エバネッセント波	48	回転ニボウディスク	20
永久電流スイッチ	178, 181	エピタキシャル成長	364, 445, 900	外部光電効果	36
永久電流モード運転	178	$f \sin \theta$ レンズ	22	界面	293
エキシトニックモデル	160	$f \theta$ レンズ	7, 10, 42	界面磁気異方性	845
エキシトンモデル	162	F 分布	968	界面準位	291, 564, 706
エキシマレーザ	102, 444	エミッター-コレクタ間充電時間	612	界面制御層	532
エキシマレーザアニール	607	エミッタ注入効率	611	界面ダイポール	528
液晶	889, 892	エミッタンス	213	界面濡れ性	1066
液晶空間光変調器	13	M 細胞層	72	界面不安定性	1059
液晶表示デバイス	928	エリブソメトリ	27, 916	界面ラフネス散乱	536
液相エピタキシー	430	塩基性ガス	667	解離化学吸着	323
液相エピタキシャル成長	431, 867	演色性	75	解離性付着	731
液体封止引上げ法	420	遠赤外レーザ	1028	解離・電離過程	729
液体レーザ	92	円筒鏡型エネルギー分析器	298	解離度	733

ガウス結像	212	加算問題	158	簡易型 RF 2 極方式	347
ガウス単位系	820	可視光センサ	808	感温磁性材料	878
蛙飛び法	447	ガスクラスタイオン	355	環境汚染物質排出移動登録制度	669
化学炎	248	ガス構造設計	729	環境相	402
化学機械研磨	692	ガスセンサ	933	環境保全	669
化学気相成長	357	ガスソース MBE	439	還元領域表示	505
化学吸着	320	仮説検定法	968	ガン効果	508, 583
化学吸着位置	323	仮想画像	964	換算係数	562
化学吸着エネルギー	323, 324	加速器中性子源	241	干渉型光スイッチ	57
化学吸着結合長	322	加速器陽電子源	242	干渉計型素子	24
化学シフト	300	加速度センサ	645	干渉縞計数法	979
化学センサ	932	カソードスパッタリング	346	間接交換結合	846
化学的修飾	801	カソードルミネッセンス	222	間接遷移型半導体	498, 508
化学的スパッタリング	727	片側階段接合	580	間接測定	949
化学的秩序	798	硬さ	333	完全結合長	121
化学量検出デバイス	646	片持ち梁	307	完全潤滑	334
化学量論的組成	256	活性化トンネリング機構	385	桿体	71
鏡	7	活性領域	585	ガン・ダイオード	582
可観測	973	合致法	980	カンチレバー	307
書換え型光メモリ材料	33	カット面検査装置	256	貫通転位	112
書込み磁界	856	荷電欠陥	786, 800	カンデラ	977
架橋剤	724	価電子交換	782	ガンマ変換	964
核共鳴前方散乱	270	価電子制御	779, 800	ガンメル数	587
核共鳴非弾性散乱	271	価電子帯	496, 506	ガンメルプーン・モデル	591
核共鳴ブラッグ散乱	270	価電子励起	328	緩和	323
核形成	404	荷電粒子放射化分析	246	基	502
カーク効果	589	可動イオン電荷	707	幾何異性体	888
殻構造	546	カビッツア抵抗	1013	希ガスイオンレーザ	96
拡散過程	448	カプラー	30	希ガスハライドエキシマ	102
拡散係数	736	下部臨界磁界	150	機器中性子放射化分析	246
拡散長	736	可変矩形	721	疑似格子整合	498
拡散定数	1062	可変しきい値型メモリセル	200	希釈冷凍機	1007
拡散電位	577, 917	可変波長レーザ	253	基準関数	988
拡散転写法	31	可変表面弾性波デバイス	879	基準素子	956
拡散電流	577	可飽和吸収作用		希土類イオンレーザ	91
拡散反射板方式	931	遅い——	130	気水界面	894
拡散防止バリア層	390	速い——	129	気相成長	406
拡散方程式	736	過飽和状態	403	気相成長法	432
核磁気共鳴	792	過飽和度	412	気相輸送法	424
核成長	347, 363	カーボングラス抵抗温度計	1012	基礎物理定数	198
核整列温度計	1011	カーボン抵抗温度計	1012	気体温度計	987
核層混合型成長	363	カーボンナノチューブ	306, 379	期待値	967
核阻止断面積	234	硝子体	71	基底ベクトル	503
拡大機構	972	ガラス転移温度	797, 798, 800	輝度	213
核断熱消磁	1010	カラーセンサ	808	希土類遷移金属	854
角度依存性	914	カルコゲナイド	805	キナクリドン	927
角膜	71	カルコゲナイドガラス	762, 797	ギニエ法	391
隔膜真空計	1045	カルコゲナイド光ファイバ	812	擬 2 元合金	508
確率分布関数	966	ガルバノミラー	19, 20	擬破壊	707
確率密度関数	966	ガルバノメータスキャナ	10	希薄環境相	402
核励起子	270	カルマン・フィルタ	972	希薄磁性半導体	854
化合物半導体	103, 360, 430, 498	過冷却急冷凝固	1060	基板温度	899
II-VI 族——	430, 498	過冷却度	403	基板結晶の選択	431
III-V 族——	430, 498	カー・レンズ効果	131	基本単位格子	503
n 元——	103	カー・レンズモード同期	130	基本ベクトル	503
仮想結晶モデル	509	簡易型 DC 2 極方式	347		

逆狭チャネル効果	680	鏡面反射	384	空乏層	577
逆格子	503	共役	888	空乏層幅	917
1 次元格子の——	364	共有結合	500	区間推定	967
2 次元格子の——	364	強誘電性	891	くさび型構造	846
逆格子空間	503	強誘電性液晶	893	屈折率	4, 105
逆格子とエワルド球の関係	363	誘電性液晶セル	929	——の外部力効果	452
逆格子マップ法	468	強誘電性薄膜	709	屈折率異方性	893, 928
逆光電子分光法	291, 301	強誘電体結晶	118	屈折率楕円体	450
逆磁区の発生サイト	840	強誘電体不揮発性メモリ	709	屈折率分布光学素子	9
逆磁歪	824	行列表示法	286	クヌードセン・セル	844
逆阻止サイリスタ	626	極高真空	1039	クライオエレクトロニクス	186
逆導通サイリスタ	626	——測定	1047	クライオスタット	1003
ギャップ状態	764	局在効果	537	³ He——	1006
ギャップ電圧	187	局在準位	782	グラウンドプレーン	689
キャパシタンス温度計	1013	局在振動	562	グラジュアルチャネル近似	595, 614
キャリア	496, 595	局在中心内発光	769	クラスタ	414
——の発生-再結合	578	局在電子-正孔対発光	768	クラスタイオンアシスト蒸着	356
キャリア速度飽和	600	極磁気カー効果	853	クラスタイオンビーム法	843
キャリア注入型エレクトロ		局所密度近似	320	クラッド	113
ルミネッセンス	925	局所領域処理	965	グラニュー型トンネル系	849
キャリア濃度	917	極浅イオン注入	355	グラフオエビタキシー	445
キャリア捕獲モデル	786	極浅分布制御	236	クラマース-クローニツヒの	
吸収係数	638	巨大磁気抵抗効果	846	関係	29, 387
吸収端	388	巨大磁気抵抗材料	847	クラマース-クローニツヒ変換	915
吸収分光	915	巨大光収縮	802	クリティカル照明	18, 22
急速酸化法	708	許容帯	505	クリティカルパス	687
吸着過程	448	記録材料	810	クリティカル面積	665
吸着反応	728	均一核形成	404	クリテジスタ	644
吸着平衡式	318	均一電子ガス	322	クリーンルーム	667
球面収差	221, 905	近距離電磁相互作用	55	グルコースセンサ	932
キュリー温度	822, 854	金蒸気レーザ	101	グループ振動	251
キュリー点記録方式	863	禁制帯	505	グレンジング	177
境界潤滑	334	近接効果素子	187	クロストークノイズ	689
共重合体	890	近接効果補正	721	クローバー回路	1023
凝集関数	322	近接場光	54, 55	グローバル段差	693
凝集構造	898	近接場光学顕微鏡	27, 55, 565, 916	グローバル配線	685
凝縮性有機物	667	近接場光記録	866	グロー放電	248
共焦点	19	金属汚染	667	クロライド法	433
共焦点型レーザ顕微鏡	395	金属/金属界面	293	クーロン振動	631
共焦点顕微鏡	43	金属島状膜	387	クーロン・ステア・ケース	546
強制効果	847	金属-絶縁体-半導体構造	531	クーロン島	631
鏡像ポテンシャル	292	金属薄膜	360	クーロン・ブロッケード	546, 631
狭帯域薄膜干渉フィルタ	25	金属/半導体界面	293	群速度	505
凝着エネルギー	332	均等色空間	74	群速度分散	129, 132
狭チャネル効果	601, 678				
協定世界時	976	空間位相変調器	132	経験的ポテンシャル関数	447
共鳴イオン化法	233	空間格子	456	経験的誘電関数	390
共鳴効果	888	空間的コヒーレンス	22	蛍光 X 線	311
共鳴準位	291	空間電荷	783	蛍光顕微鏡	936
共鳴状態	321	空間光変調素子	12	蛍光スペクトル	915
共鳴多光子イオン化法	316	電気アドレス型——	13	蛍光分光	915
共鳴トンネル効果	538	光アドレス型——	13	経時的絶縁破壊	706
共鳴トンネルダイオード	538, 628	空間分解能	18	傾斜接合	580
共鳴ホットエレクトロン		空帯	506	形状異常	732
トランジスタ	629	空燃比センサ	647	形状磁気異方性	386
共鳴励起波長	253	空乏	593	計測	971

ケイ素銅板	828, 875	光学活性	455	酵素センサ	932
6.5wt%——	829	光学活性体	888	広帯域発振利得幅	93
1 方向性——	829	光学ギャップ	766, 797	高抵抗グラニューソフト磁性膜	836
方向性——	828, 875	光学格子スケール	980	光電管	38
無方向性——	829	光学遷移	782	高電子移動度トランジスタ	500, 613
系統誤差	949, 959	光学弾性軸	450	光電子増倍管	38
ゲージファクター	385	光学定数ハンドブック	29	光電子分光	263
欠陥のクラスタリング	665	光学的一軸性	451	光電変換	36
欠陥評価	561	光学的自動制御	56	光電変換素子	60
欠陥プールモデル	785	光学的二軸性	451	光電面	36
欠陥密度	665, 706	光学的評価法	559	——の分光感度特性	37
結合エネルギー	300	光学ヘッド	862	光度の標準	977
結合型	848	光学密度	915	光熱偏光分光法	782
結晶化速度	810	交換結合定数	825	光波混合	16
結晶光学	450	交換スプリング磁石	841	2——	16
結晶格子位置	234, 235	高輝度の光源	262	4——	16
結晶構造像	220	合金系材料	784	高非線形ファイバ	132
結晶磁気異方性	822, 837	合金薄膜	854	降伏	579
結晶成長	919	アモルファス——	835	降伏応力	334
結晶成長温度	434	合金膜		降伏電圧	585, 589
結晶の対称性	456	CoCr 系——	843	高分解能低速電子エネルギー	
結晶場分裂	507	Ni-Fe——	843	損失分光	914
結晶微粒子	364	航空機実験	1058	高分子	899
ゲートターンオフサイリスタ	626	光結晶化	802	——材料	889
Kennelly 方式	820	抗原抗体反応	938	——の構造	890
ケラー照明	18, 22	光黒化現象	802	——の電気物性	890
ゲルマニウム抵抗温度計	1012	交互ヘテロ LB 膜作製法	896	高分子ラジカル	734
減圧酸化	708	交互累積	900	高平行 X 線トポグラフィ	471
検光子	28	虹彩	71	高密度波長多重伝送	110
原子		光酸化	802	高密度分子メモリ	892
——の操作	57	光軸	71, 451	高誘電率材料	708
——の誘導	57	光軸角	451	高誘電率絶縁体薄膜	236
原子価交替対	764, 799	格子欠陥	366	交流ジョセフソン効果	192
原子間力顕微鏡	306, 333	高次構造	890	交流損失	828
現実的表面	525	格子縞	220	交流ブリッジ	997
検出限界	250	格子振動	251	光量子放射化分析	246
原子炉中性子源	242	格子整合	498	小型気体冷凍機	1004
現像効果	30	格子整合系	105	小型ロケット実験	1058
元素半導体	498	高次ソリトン	133	固化率	407
IV 族——	762	格子定数	104	国際宇宙ステーション	1058
元素マップ	905	格子投影法	43	国際温度目盛	976
研磨剤	696	格子不整	257	国際キログラム原器	975
研磨終点検出器	696	高周波デバイス	616	黒体放射	75
研磨布	695	高周波誘導結合プラズマ炎	249	コサインエラー	980
検量線法	250	高周波用電子電圧計	995	固相エピタキシー	169, 402
		高純度結晶	431	固体撮像素子	60
コア	113	高真空	898, 1039	固体潤滑剤	334
コア・ロス	905	高水準注入	579	固体ソース MBE	439
高圧ガス保安法	668	合成波長法	980	固体内衝突カスケード	238
高圧酸化	708	光析出現象	802	固体レーザ	
高域フィルタリング	965	構造の乱れ	762	LD 励起——	91
高エネルギーテイル	733	構造敏感性	497	高出力——	92
光音響測定	937	高速育成	414	波長可変——	91
高温超伝導	159	光束干渉測光法	395	コットン-ムートン効果	455, 853
光化学気相堆積法	56	高速・広視野角技術	642	固定パターン雑音	62
光学異性体	888	高速フーリエ変換	966	ゴニオメトリ	467

コノスコープ像	459	左右像	456	しきい値電圧	595, 596
コヒーレンス長	44	サリサイド	715	しきい値電流	111
コヒーレント SR	212	酸化インジウムスズ	897	しきい値特性	893
互変異性	888	三角測量法	43	磁気異方性	822
固有接合	173	酸化物電流リード	178	磁気異方性定数	386
固溶度	735	酸化物薄膜	444	磁気カー効果	455, 853, 864
孤立電子対	762, 797	酸化膜欠陥	706, 707	磁気計測技術	869
コリメータ	714	3 極管型電離真空計	1046	磁気光学効果	852
コロイド集積	1066	3 極プラズマ CVD	794	——の量子的起源	854
ころの原理	334	3 元化合物	810	磁気光学材料	852
混合状態	156	三原色	110	磁気コントラスト	222
混晶半導体	498, 508	三刺激値	73	色差	74
コンタクトスライダ	56	3 次元アトムプローブ	305	磁気スケール	980
コンタクト抵抗率	691	3 次元核生成	367, 369	色素	34
コンデンサバンク	1022	3 次元分析	235, 236	磁気相図	158
近藤効果	547	三重項状態	93	色素レーザ	129
コンフォーカル	19	三重項励起子発光	769	磁気弾性エネルギー	824
コンフォメーション	890	酸性ガス	667	磁気超解像法	865
		酸素	1003	磁気抵抗	513
		酸素イオン注入法	709	磁気抵抗効果	513, 878
		3 相接触線	895	磁気抵抗効果型ヘッド	855
差圧真空計	1045	3 槽法	413	磁気抵抗素子	643
サイクロトロンエネルギー	537	3 相モデル	29	磁氣的超解像	34
再結合	926	酸素空位	706	磁気トルク	824
再結合電流	579	散弾雑音	599	磁気バブル	866
再構成	323	三端子型光スイッチ	57	磁気バブルガーネット	867
最小偏角	23	酸発生剤	725	磁気ヒステリシス	826
サイズ効果	364, 383	散布図	969	磁気ヒステリシス環線	826
再生モード同期ファイバレーザ	134	散乱因子	234	磁気ひずみ	824
細線効果	715	散乱吸収コントラスト	219	磁気フォノン共鳴	513
最大ジョセフソン電流	187	散乱コントラスト	722	磁気複屈折効果	455
最大発振周波数	588, 599	散乱断面積	234, 905	磁気浮上	180
最稠密	502	残留応力解析	392	仕切り板	894
サイドエッチング量	734	残留損失	828	磁気履歴	826
細胞	934			磁区	825, 869
サイリスタ	625	ジアゾナフトキノン	724	時空変換	958
さぐりコイル	998	ジアゾニウム塩	31	磁区構造	386
差周波発生	124	ジェリウム模型	321	磁区細分化	876
差周波変換	454	シュルツァー焦点	220	自己位相変調	129
サチコン	60	紫外光源	102	自己位相変調効果	132
雑音	949	紫外光電子分光法	300, 916	自己共振周波数	878
雑音温度計	1011	紫外線硬化樹脂	811	自己振幅変調	129
雑音指数	588, 615	磁界センサ材料	855	自己束縛	769
撮像管	60	磁界中時効	836	自己組織化膜	898
撮像デバイス	59	磁界変調方式	863	仕事関数	307, 594, 913
サテライト反射	394	磁化過程	826	自己補正型の方法	310
差動構造	951	磁化曲線	998	視軸	71
差動電圧計	994	磁化困難軸	823	脂質膜	932
サニャック効果	48	直衝突イオン散乱分光	309	磁石	
サブ keV 注入	739	磁化容易軸	823	Fe—Cr—Co——	836
サブスレッシュホールド係数	597	磁化率	821	MK——	836
サブスレッシュホールド領域	595	時間スペクトル	270	Nd—Fe—B 系——	840
サブバンド間光学遷移	540	時間に依存する摂動論	854	SmCo ₅ ——	837
サブバンドギャップ光吸収	800	時間の標準	976	シース (鞘)	729
サーミスタ	644	時間反転波	15	指数関数裾吸収	765
サーモトロピック液晶	892	しきい値	330	シース電圧	729

磁性薄膜	386, 842	周波数変調検出法	307	触針型表面あらさ計	333
磁性薄膜インダクタ	877	充滿帯	506	触針式膜厚計	396
自然画像	963	重力偏析	1061	ジョセフソン効果電圧標準	198
自然幅	268	自由励起子	560	ジョセフソン・サンブラ	194
磁束のクリープ	158	縮退現象	497	ジョセフソン接合	878
磁束のピン止め	157	縮退 4 光波混合	15	ジョセフソン接合アレイ	198
磁束フロー状態	157	種結晶	428	ジョセフソン接合素子	187
磁束量子	156	主鎖切断	724	ジョセフソン定数	198
磁束量子化	150	主走査方向	42	——の協定値	198
磁束量子転送型メモリセル	200	シュタルク効果	253, 254	ショックレー準位	291
磁束量子パラメトロン	199	シュタルクはしご	536	ショックレー・ダイオード	625
実効移動度	597	受動型保護	178	ショットキー極限	529
実効質量	506	受動センシング	954	ショットキー障壁	498, 529, 565, 581
実効剪断強度	334	シュブニコフド・ハース効果	513	ショットキー障壁高	529
実効型交流電子電圧計	995	受容野	72	ショットキー接合	783
実効的電子相関エネルギー	781, 786	ジュール加熱	730	ショットキー接触	581
負の——	799	シュルツ真空計	1046	シリサイド	565, 715
実効表面再結合速度	533	準安定励起原子	911	試料振動法	1027
実効偏析係数	407	潤滑技術	334	磁歪	824
実在表面	333	瞬間発光型	930	真空材料	1049
実時間観察	776	準結晶	457	真空蒸着法	842, 898
質量の標準	975	準粒子トンネル電流	203	真空度標準	1048
質量分析計	230	常圧 CVD	357	真空の質	1040
シティリナー-ウェーバー・		常圧酸化	708	真空マイクロエミッタ	649
ポテンシャル	447	昇温脱離スペクトル	326	シンクロトロン放射	209
磁場強度の測定	1026	昇温脱離法	326	シングルモードファイバ	113
磁場侵入長	203	昇華法	428	シンクロトロン放射光	910
自発核形成	404	蒸気圧温度計	1011	神経節細胞	71
自発磁化	821	蒸気流分布	343	人工格子	844
自発分極	891	晶系	456	人工原子	546
自発放射自己増幅	211	常光線屈折率	451	人工分子	547
磁場変調法	1027	消光比	460	深溝分離	679
磁壁	825, 869	小細胞層	72	人工放射性同位元素	240
磁壁移動	35	消磁状態	826	人工網膜チップ	647
磁壁エネルギー	825	照射線量	240	新固体レーザ	129
島状構造	345, 843	少数キャリア	497	刃状転位	366
シミュレーション	447	——の注入	497	真性キャリア密度	511
寿命	335	少数キャリア蓄積効果	581	真性半導体	511
車載冷凍機	181	少数電子のデバイス	548	振動エネルギー	323
写真乳剤	30	状態推定	972	振動写真法	256
遮断周波数	598	蒸着重合	899	振動鏡スキャナ	10
シャドウイング効果	309	蒸着薄膜材料系	926	振動励起	328
シャドウコーン	309	焦点距離	212	シンニング	696
シャピロ・ステップ	192, 203	焦電効果	120	振幅反射率	853
周期境界条件	447	常伝導電子リニアック	211	信頼区間	967
重クロム酸ナトリウム	31	衝突電離	515	信頼度	967
重合	899	衝突パルスモード同期	94, 130	水質モニタ用センサ	933
集光モード	56	蒸発係数	342	水晶振動子	395, 933
収差	212	蒸発源	342, 346	水晶体	71
修飾入力	959	蒸発速度	342, 899	水浸レンズ	18
重水素	708	蒸発分布	342	水素	1003
自由スペクトル域	24	上部臨界磁界 (磁場)	150, 1019	——の結合形態	792
集積回路	499, 616	情報蓄積技術	855	水素化アモルファス Si	780
収束電子線回折法	219	照明・集光モード	56	水素希釈	794
自由電子レーザ	210	照明モード	56	水素プラズマ照射	691
柔粘性結晶	889	初期磁場	1024		

水素放出	793	スペックルグラム	45	絶対熱電能	522
錐体	71	スペックル写真法	45	ゼーベック係数	522
垂直磁化方式	855	スペックルひずみ計	46	ゼーベック効果	522
垂直磁化膜	386, 843, 846, 864	スペックル法	46	ゼーマン効果	253, 255
垂直磁気異方性	386, 845	Smart Cut 法	680	セミグローバル配線	685
垂直浸漬法	895	スマートピクセル	58	セル成長	408
垂直転送 CCD 部	60	スメクチック	892	セルフアライン	619
スイッチングレギュレータ	877	スライドポート法	430	セルフコンシステントな磁化分布	856
推定法	967	スリューレート	960	閃亜鉛鉱型構造	365, 502
水平 CCD 部	60	スロープ因子	530	全圧真空計	1045
水平細胞	71	寸法形状	663	遷移金属酸化物	849
水平付着法	895			遷移金属表面	321
水平ブリッジマン法	421	正規化周波数	113	遷移放射	212
スキャナ	22	正規凝固	407	全応力	381
スクラッチ法	383	正規分布	967	線形化	972
スケーリング	706, 958	正極点図	392	線形ダイナミカルシステム	972
スケーリング則	602, 614	制限視野回折法	219	旋光性	455
スケーリング理論	765	正孔	496, 507	浅溝分離	679
裾状態	784	重い——	507	センサ	954
スターカプラ	116	軽い——	507	センサフュージョン	647
スチーム酸化	708	正孔注入／輸送層用材料	927	線磁歪	824
ステップ	21	正四面体配位	500	センシングシステム	954, 959
ステップエッジ (段差型) 接合	173	正常構造結合	798	センシング素子	954
ステップ型ファイバ	113	清浄度	667	潜像核	30
ステップフロー成長	445	清浄表面	525	選択 MOVPE 成長法	110
Staeblér-Wronski 効果	785	生成・再結合雑音	599	選択酸化分離	678
ステレオ投影	256	生体機能測定	935	選択成長	441
ストイキオメトリ	257	成長層厚さ	431	選択ドーブヘテロ接合	613
ストークス・シフト	769	成長モニタリング	776	選択律	251
ストライプ磁区	866	成長様式	363	選択励起	135
ストライプ相	898	静電型トロイダル分析器	236	センダスト	829, 843
Stranski-Krastanov 型成長	363	静電浮遊法	1057	剪断応力	56
ストリーク管	39	静電マイクロモータ	648	剪断抵抗	334
Street のドーピングモデル	781	静電誘導サイリスタ	626	鮮度	932
Street-Mott モデル	799	生物フォトン測定	936	セントラルドグマ	934
スパーク	248	精密モールド成形	5	全反射	311
スパッタ	346	整流型交流電子電圧計	995	全反射赤外分光	776
スパッタ中性粒子質量分析法	231	赤外吸収法	562	線分散	23
スパッタ法	842, 844	赤外光伝送	812	前方散乱フィルム方式	931
スパッタ率	346, 356	赤外センサ		全放射温度計	987
スパッタリング	254, 346	——の分光感度特性	40	前房水	71
スパッタリング収量	231	赤外多光子解離法	135	相関係数	969
スピニングロータ真空計	1045	赤外透過トポグラフ	563	相関分析	969
スピノーダル変態	836	赤外発光法	316	双極細胞	71
スピン SEM	870, 875	積層型 CCD	808	双極子近似	312
スピン依存散乱	848	積層型素子	927	双極子散乱	289, 290
スピン軌道相互作用	507, 854	積層型電池	796	——に寄与	289
スピン検出器	875	積層欠陥	111, 364	双極子力	57
スピンバルブ膜	849	積層膜	844	相互相関	46
スピン偏極 STM 技術	871	セクショントポグラフ法	472	走査型顕微鏡	19
スピン偏極ベクトル	875	絶縁ゲート電界効果トランジスタ	497	走査型光学顕微鏡	17
スペクトル変換	958	設計ルール	617	type 1——	19
スペクトル解析	970	接触 (斥力) 方式	307	type 2——	19
スペクトル推定	971	接統孔アスペクト比	689	走査型トンネル	
スペースシャトル	1058	鉄損	875	顕微鏡	292, 306, 332, 871
スペックル	44, 45	絶対真空計	1045		

走査型プローブ顕微鏡	27, 306, 892	体積磁歪	824	単色光器	26
走査容量顕微鏡	565	ダイソン型	21	単色放射温度計	987
双晶	364, 366, 369	帯電エネルギー	631	弾性散乱電子	905
層状成長	320, 363	ダイナミカルビート	271	弾性定数	893
層成長	405	ダイナミックメモリ	621	弾性表面波素子	933
相対感度係数	230	第 2 高調波発生	27, 453	単層成長	347
相転移	286	第 2 種超伝導体	150	短チャネル効果	601
相反定理	858	第 2 種不純物障	1059	タンデム太陽電池	639
相分離	1061	タイプ III	526	単電子トランジスタ	631
相変化	810	タイムオブフライト法	918	端電流	544
相変化光メモリ	35	ダイヤモンド構造	365	断熱	1005
双方向サイリスタ	626	太陽光選択膜	389	断熱消磁	1009
測定	971	太陽電池	637, 796	タンバク質	934
測定結果	948	ダイレクトマトリクス	929	短絡エミッタ構造	626
測定誤差	948	Tauc-Lorentz の式	29		
測定量	948, 971	楕円偏光	28	地球温暖化	731
速度オーバーシュート効果	600, 614	楕円率	852	——対策	734
速度変調トランジスタ	632	倒れ補正系	42	——問題	729
束縛エネルギー	510	高さ一定モード	306	蓄積	593
束縛状態	321	ターゲット	346	蓄積リング	268
束縛励起子	561	多元系材料	791	チタンサファイアレーザ	91, 131
側壁保護膜	728	多光子励起	19	窒化物半導体	436, 437
組織	935	多重双晶粒子	364	秩序磁性	822
阻止断面積	234, 235	多重反射干渉法	394	秩序パラメータ	151
組成的過冷却	408	多重量子井戸	111	秩序-無秩序転移	286, 288, 291
外側膝状体	72	多重量子井戸レーザ	500	窒素	1003
その場観察	776, 1065	多色光器	26	窒素換算値	1045
ソフトエラー	592	多数キャリア	497	窒素相当圧	1045
ソフト磁性	828	多層記録	866	着色中心	252
ソフト磁性材料	826	多層光メモリ	20	チャージアップ	565, 732
アモルファス——	833	多段階光電離法	135	チャージアップダメージ	706, 729, 730
金属系——	828	タッピング方式	307	チャージドウォール	867
ソフト破壊	707	脱離断面積	328, 329	チャネリング	738
ソフトフェライト	832	縦磁気カー効果	853	チャネリング効果	235
ソリトン	132	縦線磁歪	824	チャネリング放射	212
ソレノイド巻き	177	谷間散乱	515	チャネル	595
Sommerfeld 方式	820	多波長法	980	チャネルストップ不純物	678
ゾーンリファイニング	407	ダマシン法	695	チャープ補償誘電体多層膜鏡	94
		タム準位	291	中エネルギーイオン散乱法	236
た		単位格子	503	中間状態	151
		単一磁束量子	199	中心窩	71
耐圧	706	単一磁束量子メモリセル	200	中空室	1039
第 1 原理分子動力学法	447	単一モードファイバ	48	中性子源	240
第 1 次視覚野	72	短距離秩序性	762	中性子即発 γ 線分析	246
第 1 種超伝導体	150	W のブランケット CVD	692	中性子放射化分析	246
ダイオード	576	ダンダリングボンド	284, 292, 764, 781, 784, 787, 796	注入効率	586
ダイオード抵抗温度計	1012	ダンダリングボンド欠陥	785	超音波診断装置	937
大角度偏向	213	単結晶の完全性	256	超音波光変調素子	11
耐環境性	950	単原子層成長	367	超強磁場	1023
大気寿命	734	段差被覆率	692	長距離秩序	762
大局処理	966	単磁極型ヘッド	860	長距離ファン・デル・ワールス力	332
大口径化	729	単磁極ヘッド	860	超高感度不純物分析	237
滞在時間	329	単磁区粒子	837	超格子	500, 535, 628, 629, 844
大細胞	72	単純金属表面	321	超高真空	1039
対称構造	950	単純マトリクス方式	641	超高分解能計測	236
対称反射	467			超磁歪	824

超磁歪材料	878	ΔE 効果	879	電子刺激脱	327
超階段接合	580	テレセントリック	22	電子刺激脱離	1048
超短パルスレーザ	91	電圧計	994	電子刺激脱離イオン	1047
超伝導磁気浮上鉄道	180	電圧降下	689	電子写真	32
超伝導線材	1019	電圧フォロア	960	電子収量法	311
超伝導体	379	電圧モード型論理素子	199	電子状態	910
超伝導マグネット	1019	電位コントラスト	222	電子親和力	324, 594, 912
超伝導モータ	181	電位差計	995	負の——	650
超伝導リニアック	211	転位のバーガース・ベクトル		電子親和力則	527
超伝導量子干渉計	190	の方向	256	電磁推進船	181
超薄膜	843, 844, 911	転位密度	436	電子スピン共鳴	799
超分子	934	電界イオン化	302, 303	電子スピン共鳴法	784
超平坦面形成	356	電界イオン顕微鏡	301, 302	電子線 CVD	359
調和蒸発	344	電界吸収型変調器	118	電子遷移誘起脱離	327
直接遷移型半導体	103, 498, 508	電界効果移動度	597	電子線エネルギー損失スペクトル	905
直接トンネル電流	708	電界効果測定法	918	電子線回折	905
直流ジョセフソン電流	187	電界効果トランジスタ	921	電子線超音波顕微鏡	567
チョッパ直流増幅器電子電圧計	995	電解コンデンサ	897	電子線ホログラフィ	870
		電解酸化重合	896	電子相関エネルギー	783
追記型光メモリ材料	33, 34	電解重合	896	電子阻止断面積	234
ツェナー標準電圧発生器	198	電界蒸発	302, 303, 331	電子注入／輸送層用材料	927
ツェナー降伏	579	電界電子放射	302	電子電圧計	995
		電界電子放出	332	電子と正孔の注入バランス因子	926
低温バッファ層	437	電荷移動吸収帯	252	電磁濃縮法	1024
低温プロセス化	436	電荷移動遷移	854	電磁波浮遊法	1057
低解離	733	電荷移動相互作用	889	電子ビーム縮小転写露光	722
抵抗温度計	1012	電界放射型電子銃	905	電子ビームトモグラフィ	870
抵抗計	994	電界放射顕微鏡	301, 302	電子ビーム露光	721
抵抗率	917	電界放出	529	電子プローブ径	221
低コヒーレンス干渉計	43	電荷中性準位	528	電子有効質量	105
低コヒーレンス干渉法	48	電荷発生層	33	電磁誘導方式	180
低酸化物	811	電荷輸送層	33	電子輸送効果	846
デジタルスチルカメラ	61	電気陰性度	501	点処理	964
デジタル電圧計	995	電気機械結合係数	524, 878	電子レンズ系	223
デジタルホログラフィ	44	電気光学効果	11, 118, 452	点接触	187
デジタルマイクロミラーデバイス	648	電気光学光偏向素子	11	伝送損失	812
低真空	1039	デジタル型——	11	伝送パワー	812
ディスコティック液晶フィルム	930	電気光学光変調素子	11	伝導帯	496, 507
低速電子回折	364	導波路型——	11	伝導帯構造	912
低速電子線回折法	295	バルク型——	11	伝導電子	496
低速電子透過法	912	電気推進船	181	デンドライト	1062
低速陽電子ビーム	242	電気伝導	769	伝播遅延	685
ディッシング	696	電気透析法	413	電離真空計の感度係数	1046
低鉄損特性	877	電気分解法	413	電流一定モード	306
テイル吸収	767	電気めっき	716	電流計	994, 995
テイルの幅	767	点群	457	電流磁気効果	384, 513, 846
鉄-コバルト合金	831	電子エネルギー損失スペクトル	311	電流-電圧変換器	960
鉄-ニッケル合金	830	電子エネルギー損失分光	290, 298	電流の標準	976
デバイ-シェラー環	219	電子エネルギー損失分光法	291	電流利得遮断周波数	612
デバイ振動数	153	電子エネルギー分布	732	電流利得帯域幅積	587, 588
デバイ・モデル	289	非マクスウェルな——	733	等厚干渉縞	367, 472
テーパーファイバ	132	電磁加振	181	同位元素効果	162
デプレッション型	595	電磁型エネルギー分析器	236	同位体シフト	135
Temkin の式	319	電子計数モデル	526	統一 DIGS モデル	530
デュアルゲートエッチング	734	電子サイクロトロン共鳴		統一欠陥モデル	530
デュアルダマシ	693, 695	プラズマ放電	730		

等温過渡容量法	783	内部応力	381	熱応力	381
等価回路	587	内部光電効果	36	熱拡散	737
透過高速電子回折	364	内部自由度	329	熱起電能	770
透過電子顕微鏡	364	内部ポテンシャル	912	熱雑音	599
瞳孔	71	長さの標準	975	熱雑音温度計	987
動作周波数	687	長手磁化方式	855	熱脱離法	326
銅酸化物超伝導体	441	なだれ降伏	579	熱窒化	709
同時スパッタ	349	ナノ結晶ソフト磁性材料	836	熱電界放出電流	529
銅蒸気レーザ	101	ナノ結晶膜	844	熱電効果	522
等色関数	73	ナノコンポジット磁石	841	熱電子放出	523, 529, 582
透磁率	821	ナノチューブ	649	熱電性能指数	644
同相信号除去比	960	ナノ光集積回路	57	熱電対温度計	1012
動的磁化過程	827	ナノメートルスケールの局所的な		熱電対	522
動的光制御素子	10	電気特性評価	566	熱伝導真空計	1045
導電率	916	o-ナフトキノンジアジド-5-		熱伝導率	1063
Cu 配線	715	スルホン酸エステル	31	熱電能	384
透明導電膜	389	鉛ガラスファイバ	48	熱電冷却デバイス	644
動力学的理論	471	滑らかな面	405	熱波	567
透過型電子顕微鏡	218	軟 X 線限界	1046	熱波顕微鏡	567
特性 X 線	905	軟 X 線光電子分光法	300	熱線反射ミラー	389
特性曲線	319, 724	軟磁性材料	828	熱物性測定	1062
特性値	967	軟磁性ステンレス鋼	831	熱平衡欠陥	785
トッゲート構造	607	軟鉄	831	熱平衡状態	785
ドップラー効果	253			熱力学温度	987
ドップラー・シフト	44, 46	ニアフィールド光学顕微鏡	55	熱力学的臨界磁界 (磁場)	150
ドナー	497, 510	匂いセンサ	933	ネマチック	892
深い——	497	二結晶モノクロメータ	256	ネール温度	822
ドーバント	114, 667	2 光子吸収	20	ネール磁壁	825
ドーバント依存性	734	二光子共鳴励起	254	燃焼	1066
ドーピング	497, 510, 511, 784	二光束干渉計型	25	粘性係数	893
ドーピング効果	780	二光束干渉法	981	粘性真空計	1045
ドーピング効率	780	2 次イオン	229	粘性率	1063
ドーピング誘起欠陥	781	2 次イオン質量分析法	229		
ドープ状態	897	2 次イオン収量	231	濃厚環境相	402
トポグラフィ	469	二次温度計	1011	能動型保護	178
トムソン係数	523	二軸性結晶	451	能動センシング	954
トムソン効果	523	2 次元凝縮	320	能動フィルタ	962
トムソン散乱	269	2 次元格子	286	濃度勾配法	413
トモグラフィ	235	2 次元電子	628	ノマルスキー微分干渉顕微鏡	19
朝永-ラッティンジャー液体	545	2 次元電子ガス	613	ノンボラタイルメモリ	811
トランスデューサ	954	2 次元電子系	535		
空時変換型——	958	2 次元励起子	539	は	
トランスファ真空計	1048	2 次電子	220, 875, 905		
取出し効率	926	2 重障壁構造	628	ハード磁性材料	826
ドレインエクステンション層	603	2 色法	980	バイアス磁石	868
トンネル効果	538	2 層記録媒体	811	バイアススパッタ	349
トンネル磁気抵抗効果	849	二層構造磁気メディア	860	配位金属原子数	323
トンネルダイオード	582	2 相モデル	28	バイオセンサ	932
トンネル分光電流像	307	二段階成長	446	π 共役高分子系材料	926
トンネルルミネッセンス	567	2 値化処理	964	π 共役分子	918
		入射頻度	346	バイクリスタル接合	173
な		二量体化	898	背景入力	959
		二連円筒鏡型エネルギー分析器	299	π 結合鎖モデル	285
内殻電子励起	328			配向	899
内蔵電位	577	ねじり法	382	π セル	929
内標準法	250	熱陰極電離真空計	1046, 1047	配線アスペクト比	689

配線間容量	686	パラメトリック X 線	212	反応性蒸着法	169, 441
配線スケーリング	687	バリアメタル	714	反応生成物	727
配線抵抗	686	バリウムフェライト	837	反応律速領域	434
パイ中間子	243	パルス ESR	784	反発係数	333
ハイドライド法	433	パルス磁場	1022	汎用 IC	620
倍率器	994	パルス変調	731		
ハイブリッド回路	118	パルス変調 ECR プラズマ	731	ピエゾ散乱	514
ハイブリッドマグネット	1021	パルスレーザ	444	ピエゾ抵抗効果	645
パイボラ IC	618	パルスレーザ蒸着法	170	ピオ-サヴァールの式	177
パイボラ伝導	497	パワースペクトル	970	非オーム性	385
パイボラロン超伝導	159	反強磁性スピンゆらぎモデル	160	光パルス法	981
パイボラロンモデル	160	反強誘電液晶	893	光 CVD	359, 360
パイロジェニック酸化	708	パンケーキ巻き	177	光アイソレータ材料	854
破壊読出し型	200	反磁界係数	827	光アシスト酸化	709
爆縮法	1025	反射吸収分光法	915	光アシスト窒化	709
白色干渉	980	反射高速電子線回折	843	光イオン化質量分析法	233
白色レーザ	101	反射高速電子線回折法	296, 445	光インターコネクション	58
薄膜	898, 919	反射電子	220	光音響顕微鏡	567
薄膜エッチング	618	反射電子顕微鏡	364	光音響分光法	567, 782
薄膜形成	618	反射分光	915	光化学修飾	802
薄膜トランジスタ	796, 805	パンチ	268	光架橋型フォトポリマー	32
剥離	382	パンチスルー	589, 601	光ガラス細工	802
剥離損傷	335	反跳中性高エネルギー原子	347	光吸収法	562
端状態	537	反転	593	光強度変調方式	863
パーズピーク	678	反転層容量	602	光検波電子スピン共鳴	769
裸真空計	1045	半導体ガスセンサ	647	光コンピューティング	58
波長可変レーザ	92	半導体検出器	236	光酸化還元反応	137
波長合分波回路	117	半導体スピントロニクス	632	光磁気	34
波長選択集積レーザ	109	半導体薄膜	366	光磁気記録	862
波長走査干渉計	43	半導体/半導体界面	293	光磁気記録媒体	846
波長多重伝送	115	半導体ヘテロ構造	533	光磁気ディスク	854, 862
波長チャープピング	109	半導体ヘテロ接合	613	光刺激脱離	328
波長チャープ	118	半導体レーザ	129, 500	光重合	802
波長分散	115	——の短波長化	94	光スイッチ	12, 59, 121
波長分散型 X 線分光計	224	AlGaAs/GaAs——	108	Li ₃ NbO——	121
波長ロックモジュール	110	AlGaInP/GaAs の——	108	PLC——	122
発光型ディスプレイ	925	InGaAsP/InP——	108	デジタル型——	121
発光層材料	927	InGa _N /AlGa _N 系——	112	電流注入型——	122
発光中心分子	927	赤色——	111	導波路型——	12
発光のエネルギー効率	926	波長可変 DBR——	109	ハイブリッドマトリクス——	122
発光分析用励起光源	248	光変調器集積——	109	半導体——	122
発光量子効率	926	分布帰還——	109	分岐/ゲート型マトリクス——	123
発振波長	103	緑色域——	111	ポリマー——	123
パッチクランプ法	937	バンドオフセット	526, 788	マイクロメカニカル——	12
熱発電器	644	バンドギャップ	104, 496	マトリクス——	121
バーディーン極限	529	バンド構造エンジニアリング	509	メカニカル——	12
Bardeen-Stephen モデル	157	バンド裾	763	誘電体——	121
ハープ管	60	バンド端吸収	765	光ストップ効果	801
バブル消滅磁界	866	バンド端発光	560	光スペクトラムアナライザ	26
パーボ細胞層	72	バンドテイル	763	光制御光スイッチ	813
パーマロイ	829	バンド伝導	769	光生成欠陥	786
パーマロイ転送路	867	バンド不連続	526	光切断法	43
パーメンジュール	831	バンドラインアップ	533	光センサ	36, 807
パーメンダー	831	反応性イオンエッチング	727	光増幅	16, 813
ハライド法	433	——平行平板型——	729	光ソリトン	132
パラフィン	899	マグネトロン型 (RIE)——	730	光第 2 次高調波発生	916

光弾性効果	454	非線形光学効果	115, 123, 453	表面パッシベーション	531
光ディスク	810	非線形シュレディンガー方程式	132	表面光起電力	565
追記型——	811	非走査型光学顕微鏡	17	表面フェルミ準位	564
光電子分光法	291, 563	非対称反射	257, 468	表面フォノン	288
光伝導	771	非対称反射法	391	表面不活性化	531
光電流	637	非弾性散乱	312	表面プラズモン顕微鏡	916
光導電効果	39	非弾性散乱電子	905	品質係数	828
光導電センサ	39	非弾性散乱振幅	312	ピンチオフ点	596
光閉込め	795	非弾性トンネル分光	307	ピント調節	71
光ドープ現象	802	非中心対称構造	918	ピンニング	526
光トリガサイリスタ	626	非調和蒸発	344	ピンニング力	157
光パラメトリック増幅	124	非直接遷移モデル	790		
光パラメトリック発振	124	微結晶シリコン	794	ファイバ	48
光パラメトリック発生	124	ビッター法	869	ファイバ干渉計	48
光パルス圧縮	94, 131	引張法	382	ファイバ作製	812
光ファイバジャイロ	46	比抵抗	688	ファイバブローブ	56
光偏向素子	10	ヒートシンク	854	ファイバレーザ	48, 129
機械的——	10	1 巻きコイル法	1023	Fowler-Nordheim トンネル	604
超音波——	10	ヒートモード	34, 801	ファウラー-ノルトハイムの式	302, 649
光変調素子	11	ピンニング	564	ファセット構造	436
光メモリ	56, 801	ピンニング機構	839	ファブリ-ペロ干渉計型	24
光誘起 ESR	784, 800	ピンニング磁界	839	ファラデー回転	852
光誘起異方性	803	比熱	1064	ファラデー効果	48, 455, 852
光誘起気化促進	802	非破壊読出し型論理素子	200	ファラデー法	1027
光誘起吸収	768	非輻射再結合	567, 768, 769	van der Merwe 成長	363
光誘起欠陥	785	微分処理	965	ファン・デル・ワールス力	332
光誘起現象	797	微分負性抵抗	628	フィックの第一法則	736
光誘起ダングリングボンド	784	非放物面性	508	フィックの第二法則	736
光誘起ネットワーク構造変化	787	比誘電率	688	フィードバック	956
光誘起配向結晶化	803	標準 RI 線源	240	フィネス	25
光レジスト	802	標準電圧発生器	996	フィールド酸化膜	678
光劣化	785	標準添加法	250	フィールドシーケンシャル方式	930
比感度	1045, 1046	標準電池	198	封管法	424
引倒法	382	標準電流発生器	996	フェムト秒	93
引抜法	1027	標準の光	75	フェライト	
非共鳴イオン化法	233	表面圧	894	Mn-Zn——	832
非銀塩感光材料の変遷	32	表面移動	345	Ni-Zn——	832
非結合軌道	762	表面エネルギー	332	W 型——	837
微結晶 Si 系薄膜	794	表面凹凸	333	ガーネット型——	833
飛行時間	237	表面拡散の活性化エネルギー	323	高透磁率——	832
飛行時間型電子分光法	264	表面緩和	525	低損失——	833
飛行時間スペクトル	329	表面吸着原子位置	236	マイクロ波用——	833
ピコ秒	93	表面格子緩和	284	フェルミ・エネルギー位置	785
P 細胞層	72	表面構造変化	291	フェルミ-ディラックの分布関数	511
ビジコン	60	表面光電圧法	933	フォトダイオード	37, 60
非縮退	497	表面再結合速度	533	——の分光感度特性	38
微小重力	1054	表面再構成	284, 525	フォトリソグラフィファイバ	132
——発生手段	1057	表面磁性	385	フォトリソグラフィプロセス	32
ビジョンチップ	647	表面準位	290, 526, 564	フォトリフラクティブ結晶	15
ヒステリシス	959	表面積測定	320	フォトルミネッセンス	560, 800
ヒステリシス損失	826, 828, 875	表面損傷	335	フォトレジスト	32
ひずみセンサ	808	表面超格子	629	フォトンカウンティング法	240
微生物センサ	932	表面超構造	364	フォトンモード	34
非接触 (引力) 方式	307	表面張力	1063	フォノン散乱	514
非線形屈折率効果	131	表面抵抗	203	Volmer-Weber 型成長様式	363
非線形光学	123	表面テクスチャ	795	Forouhi-Bloomer の式	29

深い準位	473	プラズマ Z ピンチ法	1019	分解能	23, 220
深い準位過渡応答分光法	473	+, - 配置	467	分岐回路	116
深さ分解能	235	プラズマエッチング	726, 729	分光エリブソメトリ	28, 29, 389, 776
深さ方向組成プロファイリング	298	低圧高密度——	729	分光器	26, 213
深さ方向分析	231	プラズマエンハンスメント	853	分光計	26
不感帯	959	プラズマ酸化法	709	分光光度計	26
不規則雑音	959	プラズマ重合膜	906	分光写真器	26
不規則雑音入力	959	プラズマ窒化	709	分光素子	23
不揮発性メモリ	604, 805	プラズマドーピング法	739	分光放射計	26
不均一核形成	404	プラズマ波	387	分散型伝導	772
不均化反応	425	プラズマフォーカス法	1019	分散関係	504
複屈折位相整合	123	プラズモンモデル	160	分散水素濃度	792
複屈折性	928	プラズモン・ロス	905	分散素子	23
複結晶配置モノクロメータ	394	ブラッグ条件	255	分散分析	968
副格子	503	フラックスゲート磁気変調法	998	分散マネージソリトン	134
複合フェルミ粒子	538	ブラッグの条件式	391	分散力	317
輻射	1005	ブラッグ反射	504	分子汚染	667
輻射再結合	768	フラッシュ X 線像	263	分子拡散	914
副走査方向	42	フラットバンド電圧	594	分子化合物	889
複素カー回転	853	ブラベ格子	457	分子鎖	889
複素屈折率	852	フラーレン	378	分子状化学吸着	323
複素旋光角	852	プランビコン	60	分子線エビタキシー	447, 842, 901
副標準真空計	1046	プランレンズ	18	分子線セル	439
副標準電離真空計	1048	フーリエ分光法	25	分子層成長	441
物質量の標準	976	フーリエ変換法	43	分子電子デバイス	918
不純物拡散	618	ブリズム	8, 23	分子動力学法	447
不純物準位	509	フリッカ雑音	599	分子内振動	251
浅い——	510	ブリッジ素子	187	分子配向角	910
深い——	511	ブリルアン散乱光	48	分子法レーザウラン濃縮	136
不純物定量分析	561	ブリルアン帯 (ゾーン)	496, 504	分子流束	342
不純物添加効果	797	プリント基板テスト	998	分数量子ホール効果	538
不純物濃度	917	ブルースター角顕微鏡	916	分流器	994
不純物分析	561	ブルーム	444		
不純物モデル	786	ブレイズ角	24	ベアード-アルパート真空計	1046
腐食	729	ブレイズ波長	24	平均自由行程	299, 344
双子の対	768	ブレーナ技術	617, 618	平均滞在時間	326
不確かさ	948	ブレーナホール効果	847	平衡蒸気圧	344
フタロシアニン	899, 901	ブレーナマグネトロン方式	347	平行成長	364
フタロシアニン顔料	33	フレネル法	874	平衡定数	433
付着係数	344	フレリッヒ散乱	514	平行ビーム法	391
付着成長	405	Frenkel-Halsey-Hill の式	320	平衡分配係数	407
付着力	382, 383	Freundlich の式	319	平衡偏析係数	407
物理吸着	323	プロセス汚染	663	並進対称性	502
物理的蒸着	842	プロセス管理方法	666	ベース走行時間	586
物理的スパッタリング	727	プロセスシミュレーション	669	ヘッドメディア間静磁気相互作用	860
歩留り	665, 667	プロセス制御	665	ヘテロエビタキシー	364, 367, 370, 437
フント則	546	ブロッキング効果	236, 309	ヘテロエビタキシャル成長	367, 369
浮遊ゲート	604	ブロッキングコーン	309	ヘテロ界面特性	789
フライアイインテグレート	21	ブロッホ磁壁	825	ヘテロ接合	497
フラウンホーファー回折像	43	ブロッホ振動	536, 630	ヘテロ接合 FET	616
プラグ形成	692	フローティングボンド	787	ヘテロ接合効果	611
フラクタルパターン	897	プロービング深さ	299	ヘテロ接合バイポーラトランジスタ	611
プラスチックレンズ	7	フロロカーボンガス	728, 734	ヘテロダイン干渉法	44
+, + 配置	467	分圧酸化	708	ヘテロダイン法	958
プラズマ	726	分圧真圧計	1045	ペニングイオン化電子分光法	911
プラズマ CVD	357, 358, 794	分圧真空計	1047	ヘビーフェルミオン	159

Heliography	31	捕獲断面積	516, 526, 782	マイクロチップレーザ	92
ヘリカルマグネット	1023	捕獲中心	515	マイクロチャネルプレート	237, 302
ベリレン	901	保護基	724	マイクロディフラクトメータ法	256
ベルグ-バレット法	470	補償	497	マイクロ波受動回路	203
ベルシュ効果	213	補償温度	854	マイクロ波プラズマ	249
ベルチェ係数	523	補償点記録方式	863	マイクロフォーカス	264
ベルチェ効果	522	ポジトロニウム	242	マイクロプロセッサ	622
ベルチエ素子	644	ポストイオン化	232	マイクロマグネティックス	825
ベレル法	447	ボックスカー積分器	962	マイクロマシニング	648
変位	236	ホットエレクトロン	514, 604, 912	マイクロマシン	648
偏極度	875	ホットキャリア効果	599	マイクロレンズアイ	19
変形ポテンシャル散乱	514	ホットキャリア劣化	706	マイクロローディング	731, 734
Henkels 型メモリセル	200	ホッピング伝導	769, 770	マイケルソン干渉計	25
偏光解析	27	ポテンシャルエネルギー曲面	323	マイスナー効果	150
偏光解析法	389, 916	母分散	967	マウンティング	
偏向回転	928	母平均	967	斜入射型——	26
偏光顕微法	869	ホモエビタキシー	364	瀬谷-浪岡型——	26
偏光子	8, 28	ポーラロン伝導	771	ツェルニー-ターナー型——	26
偏芯コアファイバ	48	ポリアミド	899	パッシュェン-ルンゲ型——	26
偏析現象	407	ポリイミド	900	ファスティ-エパート型——	26
変調ドーピング	536	ポリエチレン	899	リトロ型——	26
変調ドーピング構造	536	ポリ (ケイ皮酸ビニル)	31	膜厚分布	342
変調光電流	772	ポリゴンミラー	42	マクスウェルの速度分布則	345
変調光電流法	783	ポリサイド	715	マクスウェルの方程式	853
変調変換	957	ポリタイプ制御	428	マクスウェル分布	733
ベンデル稿法	472	ポリテトラフルオロエチレン	899	膜中固定電荷	706
偏波面保存ファイバ	48	ポリ尿素	900	マグネトプラズマ共鳴	854
		ポリビロール	896	マグネトブランバ이트型化合物	837
ポーア磁子	821	ポリフェニレン	897	マグノ細胞層	72
ポーア半径	510	ポリフェニレンビニレン	927	マクラウド真空計	1045
ボーイング効果	103	ポリフッ化ビニリデン	891, 899	マクロ偏析	1059
ポイントコンタクト素子	187	ポリフルオレン	897	摩擦	335
方位不整	257	ポリマリゼーション	727	摩擦係数	334
方向性凝固	1062	ポーリング	919	摩擦係数	335
芳香族ジアミン	927	ホール	507	マージ型ヘッド	859
芳香族性	888	ホール移動度	771	マクスウェル応力	1019
放射光		ホール係数	771	待受け時間	473
——による核共鳴散乱	268	ホール素子	998	マッハ-ツェンダー干渉回路	116
放射化学的中性子放射化分析	246	ボルツマン分布	329	マッハ-ツェンダー干渉計型	
放射化分析	245	ボルツマン方程式	512	光導波路	118
放射光	257, 301, 910	ホール抵抗率	846	マッピング	235
放射光励起角度分解紫外光		ボルマン効果	470	——測定	559
電子分光法	910	ホログラフィ干渉法	44, 46	マトリックス効果	230, 232
放射線検出デバイス	645	ホログラフィック格子	24	マランゴニ対流	1064
放射線センサ	808	ホログラム	43, 44	マルチチャンバー装置	714
放射線損傷	263	ホログラムスキャナ	10	マルチモードファイバ	114
放射能	240	ボンドギャップ	501	マルチモード分散	115
放電周波数	732	ボンド磁石	841	マンセル表色系	73
放電プラズマ	249	ボンド法	256, 394, 468		
放電励起	102			未開拓波長域	106
飽和磁化	821	ま		味覚センサ	932
飽和蒸気圧	342			見かけの接触面積	333
飽和漸近過程	826	マイクロエレクトロメカニカルシステム		ミキシング	239
飽和漸近則	826	648		ミクロなチャージング現象	731
飽和領域	585	マイクロカラーフィルタ方式	929	未結合手	525
ホール効果素子	643	マイクロストリップ線路	203	ミシビリティギャップ	498

ミスフィット転位	367	有機物	898	らせん転位	366
密着型イメージセンサ	808	有効屈折率	387	落下管	1057
ミニディスク	854, 864	有効質量	496, 506	落下実験施設	1060
ミニバンド	535	有効収量	232	落下塔	1057
ミュオン触媒核融合反応	243	有効接触面積	333	ラテラルスパッタ	356
ミュオンスピン共鳴	243	有効媒質近似	389	ラテラル成長	435
ミュ粒子	243	有効媒質理論	322	ラブラシアン処理	965
ミラー指数	504	優先配向	795	ラマン散乱	795
		誘電緩和現象	891	ラマン散乱光	48
ムーアの法則	499	誘電緩和時間	515	ラメラ構造	890
無格子モデル	506	誘電体膜	360	ラング法	256, 470
無次元熱電性能指数	644	誘電率異方性	892	ランダウ準位	537
無静圧	1054	誘電率温度計	987	ランダウ量子化	537
無対流	1054	誘導型ヘッド	855	ランプエッジ接合	173
無秩序磁性	822	誘導結合プラズマ放電	730	ランプ加熱による急速加熱窒化	709
ムービングウォール法	896	誘導磁気異方性	386, 822	ランプリング	284
無容器浮遊	1054	誘導法	1027	ランベルトの法則	251
		U 字管真空計	1045		
Meyer-Neldel 則	769, 770, 796	油浸レンズ	18	リアクタンス素子の損失の表示	996
メスバウアー分光	268	輸送剤	424	リアクティブスパッタ	348
メゾスコピック系	628			React & Wind 法	177
メモリ	620	溶液成長	406	リオ・フィルタ	26
メモリ素子	200	溶解抑止剤	724	離散フーリエ変換	966
メルトスパン法	840	陽極酸化法	709	理想因子	529
面欠陥	366	溶質輸送	412	理想表面	525
面状発光デバイス	926	陽電子源	242	リソグラフィ	209, 618
面心立方格子	502	陽電子寿命測定	242	離脱過程	448
面内分解能	235	陽電子消滅励起オージェ電子分光	242	リターデーション	853
		溶媒蒸発法	413	リチャードソン-ダッシュマンの式	523
モアレ縞	44	容量型圧力センサ	645	リチャードソン定数	523, 529
モアレ・トポグラフィ	43, 981	余弦則	342	立方晶	502
網膜	71	横磁気カー効果	853	利得帯域幅積	960
Mott の $T^{-1/4}$ 則	770	横ずらし干渉計	43	リニア同期モータ	180
モデル固体理論	527	横線磁歪	824	リフロー	692, 694
モデル誘電関数	30, 389	4f 電子	837	裏面照射型	263
モニタ項目	665	4 極子型分圧真空計	1047	粒子汚染	667
モノサイクル	132	4 極子レンズ	212	粒子間交換相互作用係数	857
モノシラン	794	四結晶モノクロメータ	256	粒子線衝撃光放射分析	238
モンテカルロ法	447	4 軸型自動回折計	256	流体潤滑	334
		4 準位レーザ	93	リュードベリ準位	255
や		4 ゾーン消光法	28	量子井戸	293, 534
		4 端子法	917	量子井戸準位	294, 844
焼付き	335	四探針法	917	量子カスケードレーザ	541
ヤング干渉縞	45	4 π 共焦点	19	量子化抵抗	631
				量子計算	547, 632
有意水準	968			量子効果デバイス	533
融液成長	405			量子効率	926
有機 EL 素子	642, 925	ライオトロピック液晶	892	量子サイズ効果	385, 534
誘起位相変調	132	ライトパイプ	22	量子細線	293, 544, 628
有機感光体	33	ライトバルブ	13	量子点	293
有機強誘電体材料	892	ライナー	1024	量子閉じ込め構造	498
有機/金属界面	910	ラウエ・カメラ	256	量子閉込めシュタルク効果	540
有機金属化合物	436	ラウールの法則	344	量子ドット	57, 545, 631
誘起効果	888	落射型照明	18	量子ドットレーザ	548
有機半導体	910	ラザフォード散乱公式	234	量子ビート	271
有機非線形光学材料	918	ラジカル	726, 794	量子物理実験	307

量子ホール効果	537	レーザ蒸着法	444	ロッキングカーブ	467
臨界温度	150, 1019	レーザ同位体分離	135	ロッキングカーブ法	467
臨界核	404	レーザ・ドップラー速度計	46	ロックインアンプ	962
臨界点現象	1066	レーザトラッピング	57	ロッドインテグレータ	22
臨界電流密度	156, 158	レーザプラズマ X 線源	262	六方晶	502
リング型薄膜インダクティブヘッド	859	レーザ誘起蛍光法	253, 316	六方稠密構造	502
		レジスト	723	ローランド円	24
類似位相整合	123	化学増幅型——	725	ローレンツ顕微法	870
ルブレソ	928	レナードジョーンズ型	324	ローレンツ-ロレンツの式	6
		レナードジョーンズ・ポテンシャル	447	ロングスローン法	714
零位法	971	レーリー法	428	ロンドン・ゲージ	151
冷陰極電流真空計	1046	ローレンツ電子顕微鏡	874	ロンドンの侵入深さ	151
励起子発光	769	レンズ	6	ロンドン方程式	151
励起状態の寿命	331	球面——	6	論理素子	199
励起スペクトル	915	紫外域用——	5		
水冷式マグネット	1020	赤外域用——	5		
零分散波長	132	非球面——	7		
レイヤー・バイ・レイヤー成長	445	レンズの開口数	18		
レイリー散乱	115	連続膜	345	Y 型累積膜	895
レーザ	248			Y 分岐導波路	116
レーザ MBE	843	漏洩磁界	870	和周波発生	27
レーザアブレーション	444, 843	ローカル段差	693	和周波変換	454
レーザ逆コンプトン散乱	211	ローカル配線	685	ワニエ-シュタルク局在	630
レーザジャイロ	46	ロータリーエンコーダ	982	湾曲ビーム真空計	1047

わ

記 号 索 引

3DAP	305		CoO	666
8 - N 則	780		CO レーザ	101
		C	CPA	137
A		C ₆₀	CPAA	246
A-P FIM	332	C ₆₀ 結晶	CPM	94, 130, 782
a-Si : H	805	C ₆₀ 膜	CPP	849
AA	245	Ca-Ge 置換型ガーネット	CTR	644
<i>ab initio</i> 計算	320	Cabrera-Mott モデル	Cu-Ag 合金	1022
AD/DA 変換器	623	CAD	CVD	357, 447
ADP	412	CAST 法	CVD 過程	1064
AES	291, 297, 364	CBE		
AFM	306, 901, 937	CCD	D	
Ag-In-Sb-Te 系材料	811	CCD カメラ	DAP 方式	928
AHR	707	CCD 撮像デバイス	DAS 構造	525
Antoniewicz モデル	327, 331	C=C 結合	DAS モデル	285
APFIM	305	CD-RW	DA ペア発光	561
APS	641	C-F 結合	DC-SQUID	191
Ar イオンレーザ	96	CIE 昼光	DCM	927
AsCl ₃	433	CIE 表色系	DC ドリフト	120
ASE	102	CIE 分光視感効率関数	Deal-Grove モデル	708
a-Si	606	CIP	DFB-LD	109
ASIC	624	CITS	DFT	966
ASO	590	C-I 結合	DKDP	413
A モデル	327	CMA	D-line	561
		CMOS	DLTS	473
B		CMOS-APS	DMD	648
B-A 真空計	1046	C-MOS 回路	DMOS	603, 627
BBD	605	CMOS センサ	DMT	615
BCS の壁	159	CMP	DM ソリトン	134
BEEM	529	CMR	DNA	934
BET 吸着式	319	CMRR	——の 2 重らせん構造	308
BIS	291, 788	Co/Cu	DNA チップ	938
Bi 置換希土類鉄ガーネット	854	Co/Pt 人工格子	DRAM	32, 620
BOX 層	682	CO ₂ レーザ	DSC	61
BPR 法	395	TEA——	DSP	622
BPSOI	680	高速ガスフロー型——	DVD	110, 811
BST 膜	710	スラブ型——	DVD-RAM	810
		低速ガスフロー（軸流）型——	DVD-RW	811
		導波路型——	DWDD	865
		封止型——	DWDM	110
		Co-Cr 系金属薄膜	dynamic-SIMS	229
		Co-Cr 系垂直磁気異方性膜		

d 波超伝導	161	GaAsMES FET	620		
		GaAs クラスト	433	J	
		GaAs 中の炭素	562		
		GaCl	433	JT 冷凍機	1005
EA 法	789	GaInAsP	104	JVD	358
EBIC	222	γ	724		
$E \times B$ ドリフト	730	GaN	435, 437	K	
ECB 方式	929	GIAR 膜	269		
ECL	617	GL のコヒーレンス長さ	152	KDP	412
ECR ポイント	730	GL パラメータ	152	KF モデル	327, 328
EDF	29	GL 方程式	152	KIT	472
EDFA	134	GM 冷凍機	1004	KLM	130
EDX	224	Goss 組織	875	Knotek-Feibelman の機構	328
EELFS	311	GTO	626	Knotek-Feibelman モデル	327
EELS	291, 298	Gummel-Poon モデル	591	KPR	32
EEPROM	604, 622	GVD	129	Kr イオンレーザ	96
フラッシュ——	604			KS 鋼	836
EESL	905	H			
EFG 法	426			L	
EL2	561, 563	HBT	611, 613		
ELA	607	Si 系——	613	LB 法	894
ELNES	311	化合物系——	612	LB 膜	894
ELO	438	HB 法	421	LCD	928
ELTRAN	680	HDD	855	反射型カラー——	931
EML	109	HDDR 現象	841	LDD 構造	600
ECP 像	222	He-Cd ⁺ レーザ	101	LEC 法	420
EPMA	223	³ He	1003	LEED	295, 364, 901
EPROM	604, 622	³ He 融解圧温度計	1011	LEET	910, 912
ESD	327	⁴ He	1002	LIDAR	255
ESR	784	HEMT	537, 613, 620	LIF	253, 316
EXELFS	311	メタモルフィック——	615	LIGA プロセス	209
		H_{FE}	586	LiNbO ₃	118
		HF ディフェクト	682	LOCOS	592, 678
		HOPG	902	low- K	391
F ₂ レーザ	101	HREELS	910	LO フォノン	388
fcc	502	Hyper-D CCD	61	LPE	431, 447
Fe/Cr	846	h パラメータ	587	LPE 法	867
FEL	210			LP モード	113
FEM	301, 302	I		LSI プロセス	618
FeRAM	709			LV	13
FET	615	IBS 法	843	LVM	562
FFT	966	ICISS	309		
FHD 法	116	ICTS	783	M	
FIM	301, 302	IETS	307		
FIT-CCD	60	IGBT	627	MAES	911
FLC セル	929	INAA	246	MAMMOS	865
FPGA	624	InAs ドット	548	MASH	623
FPN	62	InGaAs	434	MBE	447
FRAM	605, 621	InGaAsP	434	MBE 法	439, 843, 844, 900
FSA	130	In 組成ゆらぎ	112	MCE	438
f_T	587	IPES	291	MCP	237, 302
FT-CCD	61	IPS 方式	929	MCT	627
FT-IR 法	562	ISFET	647	MD	854, 864
		ISS	308	MEED	296
		ISSG 酸化法	708	MEIS	234
GaAsIC	620	IVAP	799	MEMS	648

Menzel-Gomer-Redhead モデル	327			RSFQ	199
MES FET	614		P	RTCVD	357
MGR モデル	327, 328			RVB	161
MIGS モデル	530	PAA	246		
MIP	249	PACE 法	680	S	
MISFET	646	PAES	242		
MIS 構造	531, 921	PAL-SLM	13	S-FET	200
MNOS	604	PAS	567, 782	S-HET	200
MO	854, 862	PDS	782	SAM	129, 898
MOCVD	436	PES	563	SASE	211
MOCVD 法	710	2 光子——	565	SBE 方式	929
MOMBE	440	PFC	731	SBT 膜	710
MOS	60, 617	PGA	246	SCANIIR	238
MoS ₂	902	PHB 光記録	35	Secco Etch 欠陥	682
MOSIC	619	PIES	911	SEM	220
MOS キャパシタ	593	pin 太陽電池	791	環境——	223
MOS 構造	592	PIV	46	測長——	223
MOS サイリスタ	627	PLA	624	低加速電圧——	223
MOS 電界効果	593	PLD 法	444	低真空——	223
MOS トランジスタ	592	PL 法	560	SFFT	201
MOVPE	436	PMMA	724	SFQ	199
MRI	182, 937	pMOS FET	595	SGS	130
MR ヘッド	855	pnp トランジスタ	584	SHG	899
MSEO	105	pn 接合ダイオード	577	SiCl ₂	436
MSR	865	pn 接合理論	499	SiCl ₄	436
MTP	364	PROM	622	SiC 単結晶	428
MVTL	199	PRTR	669	SILK	706
MWNT	379	p-Si	607	B モード——	707
		高温——	607	SIMOX	390
N		低温——	607, 642	SiN	854
		Pt/Co 人工格子	854	SiO ₂ /Si 界面への窒素の導入	708
N ₂ レーザ	100	PTC	644	SiOH 結合	706
NA	113	PTCDA	901	SIS	615
NAA	246	PVD	842	SIS 接合	203
NCS 表色系	73	PVDF	891, 899	SIS ミキサー	195
Nd リッチ相	840	PXR	212	Si _x Ge _{1-x} 傾斜ベース	613
Newns-Anderson の理論	320	PZT	605	Si 弱結合切断モデル	786
NEXAFS	311	PZT 薄膜	709	Si 中の酸素	562
NF	588	p 型半導体	497	SK モード	363
nMOS FET	595			SLM	12
NMR	937	R		(Sm, Zr)(FeCo) _z N _x	842
NMR 磁力計	998			Sm ₂ Fe ₁₇ N _x	841
nnp トランジスタ	584	R ₃ (Fe, M) ₂₉ N _x 化合物	842	SNMS	231
NSB	798	RBS	234	SNOM	937
NTC	644	REM	364	SOI	592, 603, 680
n 型半導体	497	REMPI	316	SOI 層	680
n 元混晶	103	REMPI 法	329	SOS	448
O		RF-SQUID	190	SP-FET	200
		RGB 表色系	73	sp ³ 混成軌道エネルギー	528
		RHEED 296, 439, 445, 843, 844, 901, 910		sp ³ 混成軌道	500
OCB 方式	929			SPA-LEED	296
ODMR	769	RHEED 振動	442	SPE	402
OLED	925	RI 中性子源	241	SPM	129, 306
OMA	1028	RI 陽電子源	242	SQUID	190, 937
OP 磁石	836	RKKY 模型	846	SQUID 磁力計	998
OSA 表色系	73	RNAA	246	SRAM	621

SR-ARUPS	910	TEOS	390	VA 方式	930
SRH 統計	533	Terfenor-D	879	VOD	60
SrTiO ₃	445	TFT	606, 922, 930	VPE 法	432
SSA	130	THEED	364		
SST	619	time-of-flight	772		W
static-SIMS	229	TiN	390		
STI	679	TL パルス	131	WDX	224
STM	306, 332, 901, 937	TMR 効果	849		
STN 方式	929	TOF	237		X
S-TTL	591	TOFRBS	237		
SV 型 GMR ヘッド	856	TOF 法	783	XAFS	311
SV 膜	849	TO フォノン	388	XANES	910
SWNT	379	TR	212	XPS	291, 300, 916
——の電子状態	380	TTL	617	XYZ 表色系	73
		TXRF	237		
T		type 1	19		Y
<i>t</i> - <i>J</i> モデル	160				
$T_1 \rightarrow T_2$ 吸収	93	U		Y-1	605
Tauc プロット	766	UPS	291, 300, 912, 916		Z
TbFeCo	854				
TbFeCo 膜	865	V		ZAF 補正	226
TDDB	706			ZnCdSe	111
Te-O-Pd 系材料	811	VAD 法	114	ZnO	389
TEM	218, 364, 901, 905	VAP	764, 799		